# LiNbO<sub>3</sub>: Fe 晶体薄片中的光爬行效应

Abstract: This paper reports a new light climbing effect in a thin sheet of LiNbO<sub>3</sub>:Fe crystal. The relevant optical properties have also been investigated.

## 一、引言

P. A. Augustov 等人用激光束照射 LiNbO3: Fe 晶体薄片时曾观察到了一种近90°的光散射。他 们还发现,在这种情况下将所有散射光、透射光、反 射光及吸收光的全部能量从入射光能量中减去后, 结果仍有相当一部分剩余能量(占入射光能量的 27%)不知耗散去向<sup>(1)</sup>。他们定性地把上述现象归 为与晶体缺陷引起的嗓音位相栅的记录有关,但没 有给出确切的解释。我们用氦-氖激光束照射 LiNbO3:Fe 晶体薄片时,除了观察到上述近90°的 光散射外,还观察到在晶体薄片内沿晶体光轴方向 爬行的光散射。本文分析了这种光散射形成的原因 与条件,并证明了这种爬行光散射正是上述剩余能 量的耗散去向;散射光在爬行过程中从晶体薄片不 断泄漏出去乃是近90°光散射的来源。

## 二、实验与结果

图 1 为实验装置简图,入射光为 e 光。实验样 品 S 为 X 切割的厚度 为 0.2~0.5 mm 的 LiNbO<sub>3</sub>: Fe (0.08 Wt%)晶体薄片。 透镜 M 在样品上形成 不同光斑尺寸的 He-Ne 激光束(λ=632.8 nm)。当 用光斑尺寸适当大的入射光与适当强的激光束垂直 照射样品时,经数秒钟后,在样品的侧向即可看见在 晶体薄片内沿光轴方向逐渐向上与向下爬行的光散 射,爬行距离可达 1 cm (见图 2(a))。随着光爬行的 出现,同时在晶体外出现逐渐增强的近 90°光散射 (见图 2(b)),而透射光的能量则逐渐减小。



光爬行效应与入射光斑尺寸有密切关系。实验 上确定,入射光斑尺寸 D 与样品厚度 d 的比值必须 约大于 4 才能出现上述爬行效应。具体来说,对于



(a) LiNbO<sub>3</sub>:Fe 晶体的爬行效应; (b) LiNbO<sub>3</sub>:F<sub>3</sub> 晶体的近 90° 光散射(在晶体上方的xy平面内拍摄的)

厚度为0.2mm的薄样品,入射光斑尺寸必须大于 0.8mm 才出现光爬行效应。 在薄样品中容易满足 上述条件。光斑愈大,光爬行效应愈显著。在满足 上述阈值条件下,光爬行效应对入射光功率也有很 强的依赖关系。在厚样品(数 mm)中,由于照射激光 束功率的限制,难以达到上述阈值条件。故厚样品 用通常的照射方式(D<d)照射时,只能观察到小角 度的光散射。图3示出入射功率为32mW时,不同 入射光斑尺寸下的透射光功率随时间的变化曲线。 图4示出光斑直径为3mm时,不同入射功率下的 透射光功率随时间的变化曲线。入射光功率小于 11mW时,透射光功率随时间变化很慢。入射光功 率增大时,透射光功率也基本上成比例增加。当入 射光功率大于 22 mW 时,透射光功率随时间衰减 很快,约30分钟后,接近最低值。尽管入射光功率 差别很大,但最低值差别很小。在入射功率为32





mW时,透射光的最大衰减可达其初值的62%。入射光波长为632.8nm时, o光入射没有观察到光爬行效应。

三、讨论

激光入射到晶体中后,入射光与晶体中的缺陷 引起的散射光形成相干场。光激发的 Fe2+ 离子在 相干场亮区产生较多的光生载流子。这些载流子被 相干场暗区中的 Fe<sup>3+</sup> 离子陷阱所俘获, 于是形成空 间电荷与相关电场按相干场的分布,进而由于晶体 的电光效应在晶体中形成嗓音位相栅[2,3],在嗓音位 相栅与相干场的位相存在差异的情况下, 使散射光 耦合放大(这种耦合放大以位相差 90°为最大)<sup>[3,4]</sup>。 当用 e 光(λ=632.8 nm)激光垂直入射到 X 或 Y 切 割的LiNbOa:Fe晶体中时,产生沿C方向弥散的光 散射<sup>[2]</sup>。在通常的实验中,照明光束的光斑尺寸 D 小于样品厚度 d, 在样品中的光耦合放大区(即照明 区)是一个如图 5(a) 所示的窄长区。在这种情形 下,只有较小散射角的散射光线1、1',在光耦合放大 区中穿行最长的距离,因而获得最大的光耦合放大; 而较大散射角的散射光线 2、2′, 在光耦合放大区中 穿行甚短的距离,不易获得耦合放大。由于放大过 程的竞争作用,只有小角散射的光线压倒优势地获 得放大,从而产生前向出射的小角散射。

10 20 30 I<sub>A</sub>(mW)

图 6 LiNbO3:Fe 晶体薄片被照射 30 分钟后透射光 与 散射光稳定值对于入射功率的依赖关系 (D=3mm)

当照明光束的光斑直径 D 较样品的厚度 d 大 得多时,如图 5(b)所示,大于全反射角的散射光线 2,2'有可能在光耦合放大区内多次反射穿行,获得 有效的放大;而小于全反射角的散射光线 1,由于每 次反射时损耗较大,(1-*B*)=0.86,不能从多次反射 穿行中获得有效的放大,而对于大于全反射角的散 射光则没有这种损耗。因此,当光照明区 *D/d* 足够 大,使得大于全反射角的散射光可在其中反射数次, 获得足够增益,明显大于前向小角散射光的增益,则 爬行光散射形成的嗓音栅将通过竞争作用压倒前向 小角光散射形成的光栅,这样前向小角散射光得不 到放大,从而主光束的能量集中转移给大于全反射 角的光散射,形成晶体内的爬行光散射。当 *D/d* 大 于某阈值(上述实验确定约为 4)时,满足全反射条 (下转第 494 页)

## 体的晕照片,它的轮廓是个五孔。

第二步用上述散射体摄制激光散斑图。 取孔径 A 为一足够大的圆孔,把图 5(a)的 五孔全包含在内,这样得到的散斑图的晕如 图 5(b) 所示。因为 A 足够大,故(14)式变 为

$$G\left(\frac{x_{f}}{\lambda f}, \frac{y_{f}}{\lambda f}\right) = \iint a(x_{2}, y_{2}) a\left(x_{2}\right)$$
$$+ \frac{qx_{f}}{r}, y_{2} + \frac{qy_{2}}{r} dx_{2} dy_{2}, \qquad (19)$$

而 a 只在五孔内不为零。所以由(16),(17) 给出的晕轮廓应和用 天 然 散 射 体 通 过 图 5(a)形式的五孔所拍得散斑 图 的 晕 轮 廓 一 样。图 5(o)即为五孔散斑图的晕。比较图 5(b)和 5(o),可知此结论正确,从而验证了 (14)式和(16)式。和图 5(o)相比图 5(b)晕

(上接第512页) 件的那部分散射光在耦合放大区放大后,将沿着晶

体的光轴方向通过全反射的方式离开照明区向上、 向下爬行,直至被晶体吸收为止。晶体在波长 632.8 nm 处的吸收系数较小( $a\simeq 2.5 \, {\rm cm}^{-1}$ ),故可以爬至 1 cm 高度才被全部吸收。我们也曾用氢激光束( $\lambda$ =488.0 nm)照明,由于晶体对该波长的吸收系数较 大( $a\simeq 12 \, {\rm cm}^{-1}$ ),只能爬行约1 mm 多一些的距离。

在爬行中的散射光线也会产生晶体的光致折射 率变化,它反过来又使散射光线产生偏离原散射方 向的散射光。这些散射光中不满足全反射条件的将 射出晶体,形成实验中所观察到的近 90°的光散射 (见图 5(c)所示)。

当 D/d 大于阈值时,入射光功率低于功率阈值 也不会产生明显的爬行效应。这是由于散射光线在 照明区被放大的过程中有一定的损耗。当入射光功 率增大时,爬行效应愈加显著,损耗掉的能量愈多, 这就使得透射功率几乎不随入射功率而改变(见图 6),由图中可以清楚地看出,只要入射功率大于150 mW,继续增加入射功率,30分钟后透射光功率的稳 中外部晕点略小,此差异是由于两者在同一 晕区内总能量不同引起的。

上述实验主要验证了(12)式中的因子 G。这里的讨论也适用于散焦散斑.这时(1) 式表示象面 x<sub>8</sub>y<sub>8</sub> 共轭面上的光场<sup>[77]</sup>。

## 参考文献

- [1] 顾德门;《傅里叶光学导论》,科学出版社,1979.
- [2] R. P. Khetan, F. P. Chiang; Appl. Opt., 1976, 15, No. 9, 2205.
- [3] F. P. Chiang, R. P. Khetan; Appl. Opt., 1979, 18, No. 13, 2175.
- [4] Roland Meynart; Appl. Opt., 1984, 23, No. 14, 2235.
- [5] 顾杰; 《实验力学》, 1981, 1, No. 4, 371

- [6] 顾杰等, «苏州大学学报», 1986, 2, No, 2, 161.
- [7] 伍小平,《物理学报》,1983, 32, No. 8, 973.

定值 *I*. 趋于某个最低值。这一特性表明, LiNbO<sub>3</sub>: Fe 晶体薄片中观察到的这一光爬行效应有可能用 于光学限制器。

本实验用的样品是哈尔滨工业大学提供的,在 此表示谢意。对温金珂、吴仲康老师在工作中给予 的协助表示感谢。

本课题为国家自然科学基金资助项目。

### 参考文献

- [1] P. A. Augustov et al.; Appl. Phys., 1982, A29, 169.
- [2] E. M. Avakyan et al.; Sov. Phys. Solid State, 1983, 25, 1887.
- [3] D. L. Staeblr, J. J. Amodel; J. Appl. Phys., 1972, 43, 1042.
- [4] Jack Feinberg et al.; J. Appl. Phys., 1980, 51, 1297.

(南开大学物理系

张光寅 武原庆 刘思敏 王进雄 1986 年5月23日收稿)